

# 核技术在交叉科学中的应用 ---正电子湮没技术和Muon技术

叶邦角



れたない

USTC





#### 核探测与核电子学国家重点实验室 State Key Laboratory of Particle Detection and Electronics 中国科学技术大学部



#### Laboratory of Nuclear Solid State Physics



### Staff and student

Professor (1)
Associate professor (1) + Lecturer (1) ,Post-doctoral (1) ,
PhD Students (12) + Master graduate students (5)



### 中国科学技术大学 核 固 体 物 理 实 验 室

#### Laboratory of Nuclear Solid State Physics, USTC











理论研究

To develop positron annihilation theory and to calculate positron behavior in materials. 探测技术

To develop new methods and techniques for positron probe.



To research microstructure of materials by using variety positron annihilation techn.

### Muon科学

To develop the first muon beam in China and to develop detecting technique for muon probe.

# LNSSP正电子装置和谱仪



#### Slow positron beam(20mCi) (1992)



#### Pulsed positron beam(50mCi) (2012)



Digital PAS (2005)



Digital CDB (2004)



Semi-digital AMOC (2009)



2D-PAS (2012)

# I. 正电子湮没探测技术及其应用

## 正电子科学



![](_page_5_Picture_0.jpeg)

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

![](_page_6_Figure_1.jpeg)

# 正电子湮没探测信息

Energy (and momentum)

- Energy and energy broadening
- AE=112ke Momentum

![](_page_7_Picture_4.jpeg)

#### Time (lifetime)

- Annihilation lifetime
- Ps-TOF

![](_page_7_Picture_8.jpeg)

Space(depth and position)

Injection depth
Position resolution

![](_page_7_Figure_10.jpeg)

Evolution Void move Defect migration

### 正电子在固体材料

Positron lifetimes in various materials – depends upon the electron density, positronium formation

![](_page_8_Figure_2.jpeg)

## 最近正电子湮没技术的发展

![](_page_9_Figure_1.jpeg)

HEP, China

TC, China

![](_page_9_Picture_4.jpeg)

### Doppler coincidence spectroscopy

![](_page_10_Figure_1.jpeg)

![](_page_10_Picture_2.jpeg)

![](_page_11_Figure_0.jpeg)

2013/12/31

![](_page_12_Figure_0.jpeg)

![](_page_12_Figure_1.jpeg)

![](_page_12_Figure_2.jpeg)

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

![](_page_13_Picture_1.jpeg)

![](_page_13_Picture_2.jpeg)

![](_page_13_Picture_3.jpeg)

2013/12/31

#### Au with cavities - 30 keV, 10<sup>16</sup> Au<sup>+</sup> cm<sup>-2</sup> implanted at 1273K

![](_page_14_Figure_1.jpeg)

2013/12/31

![](_page_15_Figure_0.jpeg)

FIG. 2. (Color) CDB ratio spectra for Fe 0.3% Cu, Fe 0.15% Cu, Fe 0.05% Cu, and pure Fe irradiated with fast neutrons at about 300 °C, together with that for unirradiated pure Cu.

### Scanning positron microscope

- Variable energy micro-beam of monoenergetic positrons
- Lateral resolution of 2 μm is achieved
- Lifetime measurements at different beam energies are possible

Principle disadvantage: broad positron implantation profile at high energies

![](_page_16_Figure_5.jpeg)

Electron and positron beam image of the surface of a test chip. Light area is SiO<sub>2</sub>, dark area is platinum

![](_page_17_Figure_0.jpeg)

Fatigue crack in copper and map of mean positron lifetime [ps] at 5 keV positron implantation energy.

### Positron annihilation spectroscopy as a basic tool for probing material

What we can provide for material scientist?

Less short measurement time;
More information with higher accuracy.

#### **Defect map**

![](_page_18_Picture_4.jpeg)

#### **Electronic density map**

![](_page_18_Picture_6.jpeg)

#### **Molecular components map**

![](_page_18_Picture_8.jpeg)

# II. Muon科学及其应用

![](_page_19_Figure_1.jpeg)

## Mu的基本性质

- 类氢性:介于电子和质子之间
   广泛的应用:
- 地球物理(宇宙射线)、粒子 物理(中微子)、材料科学 (μSR)、能源研究(μCF)

![](_page_20_Picture_3.jpeg)

粒子	电荷	自旋	质量 MeV/c <sup>2</sup>	磁矩 <sub>µp</sub>	旋磁比 γ/2π kHz•G <sup>-1</sup>	寿命 µs
е	±e	1/2	0.51	657	2800	∞
μ	±e	1/2	105.7	3.18	13.5	2.197
р	±e	1/2	938	1	4.26	œ

![](_page_21_Figure_0.jpeg)

![](_page_21_Figure_1.jpeg)

![](_page_22_Picture_0.jpeg)

![](_page_22_Figure_1.jpeg)

三体衰变: e<sup>+</sup> (0~52.83MeV)
正电子倾向于极化方向出射: W(θ) =1 + acos(θ)
表面muon: ~100%极化的μ束

# 极化Mu子束在材料中

![](_page_23_Figure_1.jpeg)

![](_page_23_Picture_2.jpeg)

µ+在凝聚态材料中:
不发生衍射或反射;
能在高电子密度区域内停留;
能使晶格产生扰动,微扰的程度与材料有关。

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

![](_page_24_Figure_1.jpeg)

 $P(t) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \cos(\gamma_{\mu} Bt)$  P(t)为极化函数, B是局域磁场

### ≻极化μ⁺的探针性:

通过极化μ+在样品中衰变产生的e+这一时间信息,计算μ+在样 品中的极化函数*P*(*t*),由拉莫方程算得样品中的磁结构。与 电子和质子相比, muon可测量范围较大的磁场。

### **Muon Spin Rotation**

![](_page_25_Figure_1.jpeg)

![](_page_26_Figure_0.jpeg)

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

![](_page_27_Figure_1.jpeg)

![](_page_27_Figure_2.jpeg)

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

 $\mu$ SR is a collection of methods that uses the muon spin to look at structural and dynamical processes in the bulk of a material on an atomic scale.

![](_page_28_Figure_2.jpeg)

#### ●弛豫时间范围较广,该方面与其他技术互补;

●对中子吸收强烈的磁性材料,可用MuSR技术研究;

●适用于磁场微观信息研究,可区分小区域内的大磁矩和大区域内的小磁矩

## MuSR技术的优势

![](_page_29_Figure_1.jpeg)

- 可测量较弱磁场 (~ 0.1G)
- 可测量较短的弛豫时间(~10<sup>-8</sup> s)
- 探测样品的频率响应范围大(10<sup>4</sup>~10<sup>12</sup>Hz)
- 外加磁场是非必需的
- 对样品的状态要求较低(固体液体均能测量)
- 对样品环境的要求较低(高温高压强中子吸收等)

## muon科学的发展和应用

![](_page_30_Figure_1.jpeg)

![](_page_31_Figure_0.jpeg)

![](_page_31_Figure_1.jpeg)

实验室	质子能量 (MeV)	质子束流 电流 (μA)	束流结构	衰变µ (µ/s)	表面µ (µ/s)	慢μ (μ/s)
ISIS (英国)	800	180	脉冲	μ+: 4×10 <sup>5</sup> μ-: 7×10 <sup>4</sup>	4×10 <sup>4</sup>	
J-PARC (日本)	3000	333	脉冲	106~7	3×10 <sup>7</sup>	2~5×10 <sup>5</sup>
PSI (瑞士)	590	1800	连续	~ <b>10</b> <sup>8</sup>	<b>10<sup>7</sup>-10<sup>8</sup></b>	16000
TRIUMF (加拿大)	500	140	连续	1~4×10 <sup>6</sup>	~ 2×10 <sup>6</sup>	

CSNS的建造为我国开展基于加速器的脉冲型MuSR研究提供了广阔的平台。

### 二、基于CSNS的Muon束线设计

![](_page_32_Picture_1.jpeg)

![](_page_33_Figure_0.jpeg)

### 1.常规表面Mu靶的设计

### ▶基于CSNS的试验型Mu源(EMuS)的设计条件:

![](_page_34_Figure_2.jpeg)

## 2.常规表面Mu输运线的设计

![](_page_35_Figure_1.jpeg)

### 3.加强型Mu源设计初步

### • 超导螺线管应用于加强型Mu源

![](_page_36_Figure_2.jpeg)

### ● 加强型Mu源设计布局

![](_page_37_Figure_1.jpeg)

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

- ☆可以同时俘获和输运表面muon,pion,和mu<sup>-</sup>(如有需要可再 升级),利用率更高,可研究更多范围的材料;
- <sup>☆</sup>提高了表面muon源的通量,理想情况下可1×10<sup>(8-9)</sup>μ+/s, 与世界上高通量的表面muon源(PSI,J-PARC)可比拟;
- ☆高能量的muon又为开展其它的实验准备了条件,尤其是低能muon。采用低温慢化的方法(效率1×10<sup>-3</sup>),得到的Low Energy muon 的量级可以用来实验,扩大了µSR探针的在纳米,多层等材料中的应用.

HAPPY NEW YEAR and thank to everyone!